

中科院上海光机所光电事业部产品介绍

Si 用途：用作半导体材料，大功率晶体管，整流器，太阳能电池等。

主要性能参数			
晶体结构	面心立方		
熔点 (°C)	1420		
密度	2.4 (g/cm <sup>3</sup> )		
掺杂物质	不掺杂	掺 B	掺 P
类型	I	P	N
电阻率	> 1000Ωcm	10 <sup>-3</sup> ~40Ωcm	10 <sup>-3</sup> ~40Ωcm
E P D	≤100/cm <sup>2</sup>	≤100/cm <sup>2</sup>	≤100/cm <sup>2</sup>
氧含量 (/cm <sup>3</sup> )	≤1~1.8×10 <sup>18</sup>	≤1~1.8×10 <sup>18</sup>	≤1~1.8×10 <sup>18</sup>
碳含量 (/cm <sup>3</sup> )	≤5×10 <sup>16</sup>	≤5×10 <sup>16</sup>	≤5×10 <sup>16</sup>
尺寸	10×3m、10×5m、10×10mm、15×15mm, Dia50.8mm, Dia76.2mm, Dia100mm 可按照客户需求，定制特殊方向和尺寸的基片		
厚度	0.5mm、1.0mm		
尺寸公差	<±0.1mm		
厚度公差	<±0.015mm 特殊要求可达到<±0.005mm)		
抛光	单面或双面		
晶面定向精度	±0.5°		
边缘定向精度	2° (特殊要求可达到1° 以内)		
取向	<100>、<110>、<111>等		
包装	100 级洁净袋，1000 级超净室		

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com